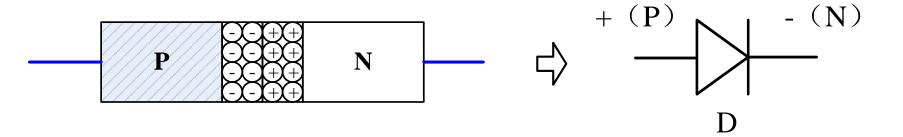


§ 2.3 PN结二极管

lugh@ustc.edu.cn 2016年9月13日



□PN结加上封装形成晶体二极管



- ■面接触型
- 点接触型

1.二极管的伏安特性

- 和PN结类似
 - □正向指数律;
 - □反向电流很小,还有反向击穿特性。
 - □ 开启电压,定义和PN结一样,Si: 0.7V; Ge: 0.3V

■ 由于指数律特性实际求解起来比较麻烦,因此常用简化的模型来处理。

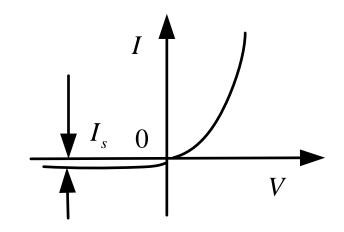
2. PN结二极管的分析模型

- (1) 数学模型
- (2) 理想模型
- (3) 折线模型
- (4)交流小信号模型

4

数学模型:
$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{KT}} - 1 \right)$$

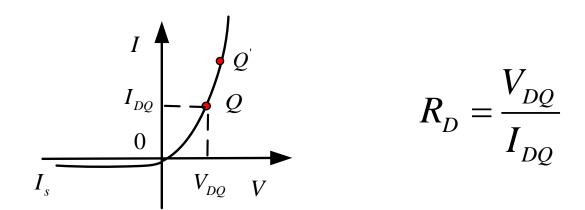
$$\Leftrightarrow V_T = KT/q \Rightarrow I = I_s \left(e^{V/V_T} - 1\right)$$



室温下(T=300K): $V_T = 26mV$



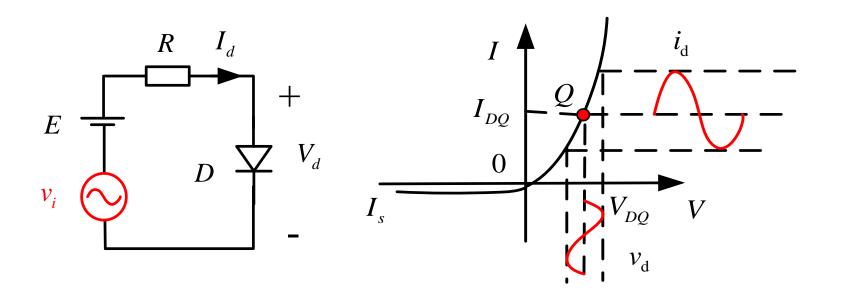
□ 二极管的直流电阻就是加在二极管两端的直流电压与 流过二极管的直流电流的比值



□ 二极管的直流电阻与直流工作点的设置相关,工作点 不同直流电阻也不同

■ 交流直流混合电路

- □直流电路为二极管设置合适的静态工作点
- □交流信号叠加在直流信号上,流经二极管,小信号



§ 2.3 PN结二极管



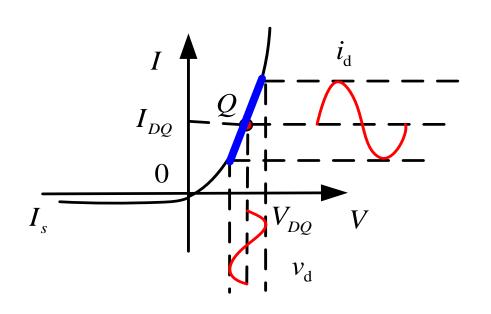
□ 二极管的交流电阻是指在直流工作点附近,二极管两端的交流电压与流过二极管的交流电流之比

$$r_d = \frac{dV_d}{dI_d}\Big|_{\mathcal{Q}} = \frac{1}{k}$$

$$r_d = \frac{1}{\frac{d}{dV_{dQ}} \left[I_s(e^{\frac{V_{dQ}}{V_T}} - 1) \right]} = \frac{V_T}{I_s e^{\frac{V_{dQ}}{V_T}}}$$

当
$$e^{V_{dQ}/V_T} >> 1$$
时, $I_s e^{\frac{V_{dQ}}{V_T}} \approx I_s (e^{\frac{V_{dQ}}{V_T}} - 1) = I_{dQ}$

$$r_d = \frac{V_T}{I_{dO}}$$
 室温下 $r_d = \frac{26mV}{I_{dQ}}$



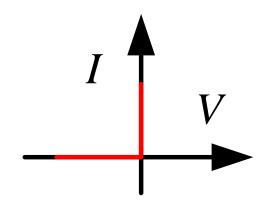
二极管的交流电阻与其直流工作点有关,是其直流工作点Q处的切线斜率的倒数,反映出二极管在直流工作点附近呈线性特性

10

(2) 理想模型

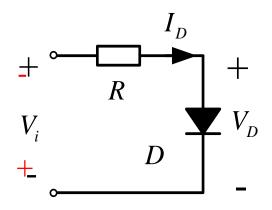
■ 理想二极管

□ 满足理想单向导电性(正向偏置时短路,反向偏置时开路)



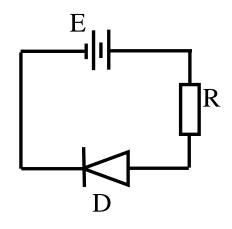
理想二极管伏安特性

(2) 理想模型



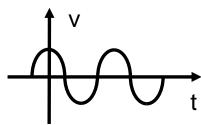
导通
$$\Rightarrow \begin{cases} R_D = 0 \\ V_D = 0 \end{cases}$$
 截止 $\Rightarrow \begin{cases} R_D = \infty \\ I_D = 0 \\ V_D \sim f(V_i) \end{cases}$

(2) 理想模型



例: R=10kΩ, 理想二极管, 求I_D, V_D。

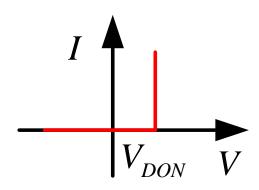
- (1) E=1V
- (2) E=-3V
- (3) E=Vcosωt



(3) 折线模型

■ 第一种折线模型

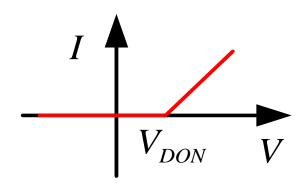
□ 直流分析时,仅考虑二极管的开启电压V_{DON},不考虑 其导通后的交流电阻,即认为**0**



(3) 折线模型

■ 改进的折线模型

□ 直流分析时,既考虑二极管的导通电压V_{DON} ,又考虑 其导通后的交流电阻



§ 2.3 PN结二极管

15

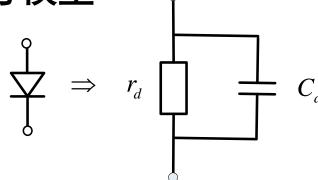
(4) 交流小信号模型



- □合适的直流偏置
- □ 输入交流信号应满足交流小信号激励条件,交流小信号分析时,二极管才能看作为线性器件。

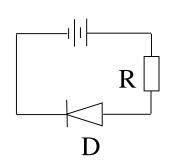
$$\Rightarrow r_d$$

■ 高频小信号模型



3. 电路分析方法





$$\begin{cases} I_D = I_s (e^{V_D/V_T} - 1) \\ E = I_D \cdot R + V_D \end{cases}$$

- □解方程
- □图解法
- □模型法
 - ■一般给定二极管的模型

